



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种硅基绝缘体上锗衬底结构及其制备方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210258454.X
申请日期:	2012-07-24
专利号:	201210258454.X
第一发明人:	王盛凯;刘洪刚;孙兵;赵威;薛百清
实施情况:	授权
专利证书号:	201210258454.X
其它备注:	高频高压中心

